

	<p><b>IPG20N06S4L11ATMA1</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPG20N06S4L11ATMA1</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 8TDSO</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPG20N06S4L11ATMA1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 11000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPG20N06S4L11ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8TDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 28µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8-4
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.2 mOhm @ 17A, 10V
Leistung - max	65W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4020pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A

IPG20N06S4L11ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPG20N06S4L11ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPG20N06S4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPG20N06S4L11ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPG20N06S4L26ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 60V 20A TDSO-8</p>	 <p><b>IPG20N06S4L-14</b> INFINEO IPG20N06S4L-14 INFINEO</p>	 <p><b>IPG20N06S4L-14A</b> INFINEO INFINEO PG-TDSO</p>	 <p><b>IPG20N06S4L14ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>
 <p><b>IPG20N06S4L-26</b> INFINEO IPG20N06S4L-26 INFINEO</p>	 <p><b>IPG20N06S4L14ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p><b>IPG20N06S4L11AATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p><b>IPG20N06S4L26AATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPG20N06S4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPG20N06S4L11ATMA1 Datenblatt	IPG20N06S4L11ATMA1-Datenblätter	IPG20N06S4L11ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPG20N06S4L11ATMA1
IPG20N06S4L11ATMA1 Electronic	IPG20N06S4L11ATMA1-Komponenten	IPG20N06S4L11ATMA1-Verteiler	IPG20N06S4L11ATMA1-Bild	IPG20N06S4L11ATMA1-Teil
IPG20N06S4L11ATMA1 Preis	IPG20N06S4L11ATMA1 Hersteller	IPG20N06S4L11ATMA1 Bild	IPG20N06S4L11ATMA1 Aktie	IPG20N06S4L11ATMA1 Inventar
IPG20N06S4L11ATMA1 Neu	IPG20N06S4L11ATMA1 Original	IPG20N06S4L11ATMA1 garantiert	IPG20N06S4L11ATMA1 RFQ	IPG20N06S4L11ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited